解説



# 表面プラズモンの基礎と応用

#### 永島圭介

日本原子力研究開発機構,量子ビーム応用研究部門

(原稿受付:2007年9月12日)

金属やプラズマのように自由電荷を持つ物質表面では、表面電荷の集団振動である表面プラズモン(あるい は、プラズマ表面波)が存在できる.この集団振動が外部から与えた電磁波と結合した系は表面プラズモンポラ リトンと呼ばれる.この表面波が存在できるのは、磁場が横波である TM モードの場合だけである.1つの境界 面に TM モードの電磁波を入射した場合、振幅反射率の特異点(分母がゼロになる点)が表面プラズモンの共鳴 条件に一致し、この条件から表面プラズモンの分散関係が得られる.ここでは、実際の実験系に見られるような 複数の境界面がある場合について、多波干渉理論を用いて表面プラズモンの正確な分散関係を求めた.さらに、 この分散関係を用いて、表面プラズモン共鳴を応用した高時間分解かつ高空間分解のイメージング測定法につい て議論した.

#### Keywords:

surface plasmon, plasma surface wave, surface plasmon polariton, surface plasmon resonance

#### 1. はじめに

固体物理におけるプラズモンとは、自由電荷(ほとんど の場合は電子)の集団振動のことであり、プラズマ物理学 におけるプラズマ波に相当する. 但し, プラズモンという 呼び名は、フォノンなどと同様に量子力学的な準粒子と見 なす場合のものである.固体中でのプラズモンは、自由電 荷の疎密波であり、電荷の振動にともなって電磁場の振動 が誘起される.この電磁場の振動は、電荷の振動に影響す るため、両者の振動が結合した系をつくることになる、一 般に、プラズモンやフォノンのような固体中での集団振動 を素励起と呼び、素励起が電磁波と結合した系をポラリト ンと呼ぶ.したがって、自由電荷の集団振動が電磁波と結 合した系はプラズモンポラリトンと呼ばれる.表面(また は、境界面)では、固体中でのプラズモンとは状況が異な り、表面での境界条件を満たす別の集団振動が存在するこ とになる[1]. これを表面プラズモンと呼ぶ. 表面プラズモ ンはプラズマ物理学におけるプラズマ表面波に相当する [2]. この表面プラズモンが電磁波と結合した系は表面プ ラズモンポラリトンと呼ばれる.本稿では、この表面プラ ズモンポラリトンについて述べるが、以下では、ポラリト ンという呼び名は省略して、単に、表面プラズモンと呼ぶ ことにする.

電磁波で表面プラズモンを励起するためには,電磁波の 位相速度が表面プラズモンの位相速度に一致しなければな らない[3].しかしながら,通常の媒質を伝搬する電磁波を 表面に入射しても,両者の位相速度が一致するような条件 は得られない.そこで,電磁波が境界面で全反射する時に 発生するエバネッセント波が用いられている[4].全反射

Basics and Applications of Surface Plasmon NAGASHIMA Keisuke を起こすためには、屈折率の異なる2つの媒質の境界面に 対して、屈折率の大きな媒質側から電磁波を入射する.入 射角をある値以上にした場合に全反射が起き、媒質による 吸収がなければ、反射率は1になる.この時、屈折率の小 さな媒質側にしみ出した電磁場(これを近接場と呼ぶ)が 発生する.この場合の近接場は、境界面に沿って伝搬する 波であり、エバネッセント波と呼ばれる.このエバネッセ ント波を用いれば、その位相速度を表面プラズモンの位相 速度に一致させることができ、表面プラズモンを共鳴的に 励起することができる.表面プラズモンが励起されると、 入射波のエネルギーが表面プラズモンの励起によって奪わ れるため、反射率は低下する.実際の実験においては、反 射率が最も小さくなる場合として、表面プラズモンの共鳴 条件を観測することができる.

表面プラズモンは、後述するプリズムを使った簡単な装 置(プリズムに厚さ50 nm 程度の金属薄膜を蒸着したもの) にレーザーを照射して励起することができ[5],バイオセ ンサーなどの幅広い用途に応用されている[6].その原理 は、表面プラズモンの共鳴条件が金属表面の屈折率変化に 対して敏感に応答することに基づいている.表面プラズモ ンの応用は、金属微粒子を用いた局在型の表面プラズモン なども含めて、ナノテクノロジーなどの新しい応用分野へ 広がりつつある[7].一方、プラズマプロセスの分野では、 プラズマ表面波が大面積のプロセス技術として実用段階に ある[8].物理的な観点からは、表面プラズモンとプラズマ 表面波は同じものであり、両者の波の分散関係は全く同一 のものになる.本稿では、表面プラズモンについて、電磁 気学的な観点からの基礎を明らかにし、多波干渉理論を用

author's e-mail: nagashima.keisuke@jaea.go.jp

Basics and Applications of Surface Plasmon

いて複数の境界面がある場合の表面プラズモンの一般的な 共鳴条件を示す.これらの考え方が,表面プラズモンの新 たな応用へ発展するだけでなく,プラズマ表面波の応用に おいても役立つことを期待したい.

## 2. 表面プラズモンの基礎

#### 2.1 表面波の考察

電磁場に対する物質の応答(物質の巨視的な性質)は、誘 電率 $\epsilon$ と透磁率 $\mu$ で表される.誘電率は分極による応答を、 透磁率は磁化による応答を表す.通常の物質においては、 分極は光の周波数に応答するが、磁化は光の周波数に追従 できない.したがって、光の周波数領域では $\mu$ は真空中の 透磁率 $\mu_0$ に等しい.この場合、マックスウェル方程式 (ファラデーの法則およびアンペールの法則)は

$$\nabla \times \boldsymbol{E} = -\mu_0 \frac{\partial \boldsymbol{H}}{\partial t} \tag{1}$$

$$\nabla \times \boldsymbol{H} = \boldsymbol{\varepsilon} \frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t} \tag{2}$$

と書ける. 但し, E は電場強度, H は磁場強度である.

ここでは、媒質1と媒質2に挟まれた平滑な境界面を考える(媒質1が物質で、媒質2が真空の場合、この境界面が物質表面となる).境界面に対して法線方向をz方向にとり、境界面の位置をz=0とする(図1).また、この境界面に対する法線ベクトルをNとする.この境界面での電場および磁場に対する境界条件は

$$N \times (\boldsymbol{E}_1 - \boldsymbol{E}_2) = 0 \tag{(3)}$$

$$\boldsymbol{N} \times (\boldsymbol{H}_1 - \boldsymbol{H}_2) = 0 \tag{4}$$

で与えられる[9].これらの式は電場および磁場の境界面 での接線成分が連続であることを意味する.

ー般に、境界面に対する電磁波の解は、磁場が横波である TM モード (transverse magnetic mode) と電場が横波 である TE モード (transverse electric mode) に分離することができる[10]. TM モードの場合、電場および磁場のゼロでないベクトル成分は $E = (E_x, 0, E_z), H = (0, H_y, 0)$ である.式1および(2)から、磁場のy成分に対して



図1 2つの媒質に挟まれた境界面の座標系.

を得る. これは横波の波動方程式を表している. ここでは, x 方向に波数 k で伝搬する単一周波数の表面波を考える. この場合,磁場の y 成分を

$$H_{y} = h(z) \exp i(kx - \omega t) \tag{6}$$

とおいて, 式(5)に代入すると

$$\frac{\partial^2 h(z)}{\partial z^2} = (k^2 - \omega^2 \varepsilon \mu_0) h(z) \tag{7}$$

を得る. 但し、 $\omega$  は角周波数である. 誘電率  $\epsilon$  が実数(吸収のない媒質)の場合、上式の右辺の括弧内の値は実数となる. この場合、解は指数関数で与えられるので、媒質1 (z < 0)において

$$h^{(1)}(z) = h_0^{(1)} e^{\beta^{(1)} z}$$
(8)

媒質2 (z>0) において

$$h^{(2)}(z) = h_0^{(2)} e^{-\beta^{(2)} z}$$
(9)

とする.ここで、 $\beta^{(j)} = (k^2 - \omega^2 \varepsilon^{(j)} \mu_0)^{1/2}$ とした.但し、jは媒質1または2を表すものとする.この解が表面に局在 する波であるためには、 $\beta^{(j)}$ はいずれも正の実数でなけれ ばならない.この条件 ( $\beta^{(j)} > 0$ )を書き直すと、  $\omega/k < c/n^{(j)}$ となる.但し、cは光速で、 $n^{(j)}$ は媒質jの屈折 率である.このことから、表面波の位相速度は媒質中での 光の位相速度( $\omega/k = c/n^{(j)}$ )と一致しないことがわかる.境 界条件(3)および(4)から、z = 0では $H_y^{(1)} = H_y^{(2)}$ かつ  $E_x^{(1)} = E_x^{(2)}$ である. $H_y^{(1)} = H_y^{(2)}$ から $h_0^{(1)} = h_0^{(2)}$ を得る.ま た、 $E_x^{(1)} = E_x^{(2)}$ と式(2)から

$$\frac{\beta^{(1)}}{\varepsilon^{(1)}} = \frac{\beta^{(2)}}{\varepsilon^{(2)}} \tag{10}$$

を得る. この式が満たされるためには,  $\beta^{(1)}$ ,  $\beta^{(2)}$  がいずれ も正の実数であることから,  $\epsilon^{(1)} \geq \epsilon^{(2)}$  の符号は逆でなけ ればならいことがわかる. 一般に, 金属やプラズマのよう に自由電荷を持つ物質では, プラズマ周波数以下の周波数 領域で誘電率が負の値を持つ. したがって, 金属やプラズ マと真空の境界面においては, 式(10)を満たす表面波が存 在し得る.

次に、TEモードの場合を考える.電場および磁場のゼロ でないベクトル成分は $E = (0, E_y, 0), H = (H_x, 0, H_z)$ であ る.式(1)および(2)から、電場の y 成分に対して

$$\frac{\partial^2 E_y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_y}{\partial z^2} = \varepsilon \mu_0 \frac{\partial^2 E_y}{\partial t^2}$$
(11)

を得る.この式は、式(5)と全く同じものであり、TM モードの場合と同様の解(式(8)および(9))を得る.境 界条件(3)および(4)から、z=0では $E_y^{(1)} = E_y^{(2)}$ かつ  $H_x^{(1)} = H_x^{(2)}$ である.これらの関係と式(1)から、

 $-\beta^{(1)} = \beta^{(2)}$ なる条件を得る.しかしながら,この条件は  $\beta^{(1)}, \beta^{(2)}$ がいずれも正の実数であることと矛盾する. 従って,TEモードの場合は,境界条件を満足する表面波が 存在できない.

#### 2.2 境界面での反射と透過

表面波が存在できるのは,TMモードの場合だけである ことがわかったので,ここからはTMモードに限って議論 を進める.まず,電磁波がある角度で1つの境界面へ入射 する場合を考える(図2).ここでは,境界面をxy面にとっ ているので,電磁波の入射面をxz面にとる.入射波*i*,反 射波*r*,透過波*t*の各成分に対する境界条件は,式(3), (4)で与えられ,

$$E_x^i + E_x^r = E_x^t \tag{12}$$

$$H_y^i + H_y^r = H_y^t \tag{13}$$

となる. アンペールの法則(式(2))のx成分と式(12)から,

$$\frac{1}{\varepsilon_1} \frac{\partial \left(H_y^i + H_y^r\right)}{\partial z} = \frac{1}{\varepsilon_2} \frac{\partial H_y^t}{\partial z}$$
(14)

を得る. 但し,  $\epsilon_1$  および  $\epsilon_2$  は媒質 1 および 2 の複素誘電率 である(ここからは、一般性のある理論を展開するために 誘電率はすべて複素量とする).

ここでは,入射面を xz 面にしているので,波数ベクトル k の y 成分はゼロである.また,入射波,反射波および透 過波の位相が境界面 (z = 0) で連続であることから,これ ら 3 つの波の波数ベクトルの x 成分は同じであり,ここで は  $k_x$  と表す.この波数ベクトルの接線成分が等しいこと は、スネルの法則を一般化したものであり,図2に示した 反射波および透過波の角度について、 $\theta^i = \theta^r$ ,および、  $\sqrt{\epsilon_1} \sin \theta^i = \sqrt{\epsilon_2} \sin \theta^i$ という関係を与える.この場合、3 つの波の磁場の y 成分は以下のように書ける.

$$H_{y}^{i}(x,z,t) = b^{i} \exp i(k_{x}x + k_{z1}z - \omega t)$$
(15)

$$H_{y}^{r}(x, z, t) = b^{r} \exp i(k_{x}x - k_{z1}z - \omega t)$$
(16)

$$H_{y}^{i}(x,z,t) = b^{i} \exp i(k_{x}x + k_{z2}z - \omega t)$$
(17)

ここで, $k_{21}$ , $k_{22}$ は媒質1および媒質2における波数ベクトルのz成分である.また, $b^i$ , $b^r$ , $b^t$ は入射波,反射波,透過波の境界面における振幅強度である.これらの式を式



図2 1 つの境界面における入射波,反射波,透過波.

(13) および(14)に代入すると,

$$b^i + b^r = b^t \tag{18}$$

$$\alpha_1 \left( b^i - b^r \right) = \alpha_2 b^t \tag{19}$$

を得る.ここで, $\alpha_j = k_{ij}/\epsilon_j$ と置いた.上の2つの式から, 磁場の振幅強度の反射率および透過率は

$$\frac{b}{b}^{r} = \frac{a_1 - a_2}{a_1 + a_2} \tag{20}$$

$$\frac{b}{b}^{t} = \frac{2a_1}{\alpha_1 + \alpha_2} \tag{21}$$

で与えられる.但し,式(5)から,それぞれの媒質におい て波数ベクトルと誘電率は

$$k_x^2 + k_{ri}^2 = \omega^2 \varepsilon_i \mu_0 \tag{22}$$

の関係にある.

#### 2.3 表面プラズモンの分散関係

振幅強度の反射率と透過率を表す式(20)および(21)において,分母がゼロとなる場合は特異点である.すなわち,

$$\alpha_1 + \alpha_2 = 0 \tag{23}$$

の条件を満たす場合には,解が発散することになる.この 特異点の条件は,表面波が存在する条件である式(10)に一 致し,周波数ωの系が固有振動する場合に相当する.つま り,この条件を満たす場合は,外部から与えた揺らぎが非 常に弱くても系が共振することになる.式(23)を書き直す と,

$$k_x^2 = \omega^2 \mu_0 \frac{\varepsilon_1 \varepsilon_2}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2} \tag{24}$$

となる.

金属のように自由電荷がある場合は、表面電荷の集団振動(表面プラズモン)が存在できるが(図3),この集団振動が電磁波と結合して周波数ωで固有振動する系(表面プラズモンポラリトン)をつくることが可能となる.式(24)は、この表面プラズモンポラリトンの分散関係を表している. 媒質1と媒質2がプラズマと誘電体(真空を含む)の場合は、プラズマ表面波の分散関係に一致する[2].また、この式は自由電荷によるプラズモンの場合に限らず、表面ポラリトンの一般的な分散関係でもある[1].

表面プラズモンの分散関係を表す式(24)から、伝搬方向



#### Basics and Applications of Surface Plasmon

の波数を求めると,

$$R(k_x) = \frac{\omega}{c} R\left(\sqrt{\frac{\hat{\varepsilon}_1 \hat{\varepsilon}_2}{\hat{\varepsilon}_1 + \hat{\varepsilon}_2}}\right) \tag{25}$$

となる. 但し,  $\hat{\epsilon}_i$  は $\epsilon_0$  で規格化した誘電率で, R() は実数 部を取り出す関数を表す. この式から,表面プラズモンの 分散関係と真空中を伝搬する光の分散関係  $k = \omega/c$  とは一 致しないことがわかる(図4). すなわち,物質の表面に直 接光を当てても表面プラズモンを励起することはできな い. そこで,光が全反射する時にできるエバネッセント波 を用いて表面プラズモンを励起する場合を考えてみる. 光 が入射する側の媒質の屈折率をn,入射角を $\theta$ とすれば,エ バネッセント波の波数ベクトルのx成分(エバネッセント 波の分散関係) は

$$k_x = \frac{\omega}{c} n \, \sin\theta \tag{26}$$

となる.したがって,入射角を適当に選ぶことによって, エバネッセント波の分散関係と表面プラズモンの分散関係 とを一致させることができる.この場合の入射角は

$$\sin\theta = \frac{1}{n} R\left(\sqrt{\frac{\hat{\varepsilon}_1 \hat{\varepsilon}_2}{\hat{\varepsilon}_1 + \hat{\varepsilon}_2}}\right) \tag{27}$$

で与えられる. 但し、ここで  $\epsilon_1 \ge \epsilon_2$  は、金属と真空の誘電 率を表す. この式が金属と真空の境界面で表面プラズモン を励起するための共鳴条件となる.

最初に、エバネッセント波によって表面プラズモンを励 起したのはオットで、プリズムを用いた全反射によってエ バネッセント波を発生させ、このプリズムの反射面のすぐ 近くに金属面を配置する方式(この方式をオット配置と呼 ぶ.図5(a)を参照)で実験を行っている[4].その後は、金 属の薄膜をプリズムの反射面に直接蒸着したものを用い て、より簡便な方式(この方式をクレッチマン配置と呼ぶ. 図5(b)を参照)で実験が行われるようになった[5].ク レッチマン配置では、光の入射側からプリズム(ガラス)、 金属、大気と3つの媒質があり、複数の境界面が存在する ことになる.したがって、1つの境界面だけを考えた場合



図4 表面プラズモンの分散関係(例として、金と真空の境界面 での値を示した).



K. Nagashima

の表面プラズモンの分散関係(24)は正確でない.

## 3. 多波干渉の理論

### 3.1 多波干渉による反射と透過

クレッチマン配置の場合からもわかるように,実際の実 験系においては複数の境界面が存在することになる.ここ では,より一般的な場合として,N層の境界面(したがっ てN+1層の媒質)を考える.第;番目の境界面については, j番目の媒質からの入射波,j番目の媒質への反射波,j+1 番目の媒質への透過波,j+1番目の媒質から帰ってくる反 射波の4つが存在する(図6).それぞれの波の磁場のy 成分を

$$H_{i}^{i} = b_{j}^{i} \exp i \left( k_{xj} x + k_{zj} z - \omega t \right)$$

$$\tag{28}$$

$$H_j^r = b_j^r \exp i(k_{xj}x - k_{zj}z - \omega t)$$
<sup>(29)</sup>

$$H_{j+1}^{\iota} = b_{j+1}^{\iota} \exp i \left( k_{xj+1} x + k_{zj+1} z - \omega t \right)$$
(30)

$$H_{j+1}^{\kappa} = b_{j+1}^{\kappa} \exp i(k_{xj+1}x - k_{zj+1}z - \omega t)$$
(31)

とする. ここでは, 第*j*番目の境界面の位置をz=0とし, 4 つの波の境界面での振幅強度を $b_j^i$ ,  $b_j^r$ ,  $b_{j+1}^t$ ,  $b_{j+1}^R$  とした. また,  $k_{xj}$  と $k_{zj}$  は *j* 番目の媒質における波数ベクトルの *x* 成分と *z* 成分である.

磁場に対する境界条件の式(4)より境界の両面において 磁場の y 成分は等しくなる.したがって,

$$(b_{j}^{i} + b_{j}^{r})e^{ik_{xj}x} = (b_{j+1}^{t} + b_{j+1}^{R})e^{ik_{xj+1}x}$$
(32)

である.境界の両面において位相は連続であることから, 上式の位相項は一致しなければならない.このことから, 一般化されたスネルの法則

$$k_{xj} = k_{xj+1} \tag{33}$$

が得られ、磁場についての境界条件は



図6 第 j 番目の境界面における4つの波.

$$b_{j}^{i} + b_{j}^{r} = b_{j+1}^{t} + b_{j+1}^{R}$$
(34)

となる.また,電場に対する境界条件の式(3)より境界の 両面において電場の x 成分は等しくなる.式(2)から得ら れる電場と磁場の関係を用いて,この条件を書くと,

$$\frac{k_{zj}}{\varepsilon_j\omega}(b_j^i - b_j^r) = \frac{k_{zj+1}}{\varepsilon_{j+1}\omega}(b_{j+1}^t - b_{j+1}^R)$$
(35)

となる. 媒質 *j*+1 の厚みを *d*<sub>*j*+1</sub> とした場合, 第 *j*+1 番目 の境界面ので入射波と反射波は,

$$H_{j+1}^{i} = b_{j+1}^{i} \exp i[k_{xj+1}x + k_{zj+1}(z - d_{j+1}) - \omega t]$$
(36)  
$$H_{j+1}^{r} = b_{j+1}^{r} \exp i[k_{xj+1}x - k_{zj+1}(z - d_{j+1}) - \omega t]$$
(37)

と書ける.これらの式を(30)および(31)と比較すると,

$$b_{j+1}^{t} = b_{j+1}^{i} e^{-ik_{2j+1}d_{j+1}}$$
(38)

$$b_{j+1}^{R} = b_{j+1}^{r} e^{i\kappa_{zj+1}a_{j+1}}$$
(39)

という関係が得られる.この関係を用いて境界条件の式 (34) および(35)を整理すると,

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \alpha_j & -\alpha_j \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_j^i \\ b_j^r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{-i\delta_{j+1}} & e^{i\delta_{j+1}} \\ \alpha_{j+1}e^{-i\delta_{j+1}} & -\alpha_{j+1}e^{i\delta_{j+1}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{j+1}^i \\ b_{j+1}^r \end{pmatrix} (40)$$

となる. 但し,  $a_j = k_{zj}/\varepsilon_j$ ,  $\delta_j = k_{zj}d_j$  と置いた. 第 j 番目の 境界面での振幅反射率と振幅透過率は

$$r_j = \frac{a_j - a_{j+1}}{a_j + a_{j+1}} \tag{41}$$

$$t_j = \frac{2\alpha_j}{\alpha_j + \alpha_{j+1}} \tag{42}$$

で与えられる.これらの式を用いて,式(40)を使いやすい形に書き直すと,

$$\begin{pmatrix} b_j^i \\ b_j^r \end{pmatrix} = \frac{1}{t_j e^{i\delta_{j+1}}} \begin{pmatrix} 1 & r_j e^{2i\delta_{j+1}} \\ r_j & e^{2i\delta_{j+1}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{j+1}^i \\ b_{j+1}^r \end{pmatrix} \equiv M_j \begin{pmatrix} b_{j+1}^i \\ b_{j+1}^r \end{pmatrix}$$
(43)

と書ける.ここで定義した行列 $M_j$ はj=1からN-1番目の境界面に対するものであり,

$$\begin{pmatrix} b_1^{i} \\ b_1^{r} \end{pmatrix} = \boldsymbol{M}_1 \boldsymbol{M}_2 \cdots \boldsymbol{M}_{N-1} \begin{pmatrix} b_N^{i} \\ b_N^{r} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_N^{i} \\ b_N^{r} \end{pmatrix}$$
(44)

となる.最終の境界面(第N番目の境界面)において は、帰ってくる反射波はないので、最終面の境界条件は

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \alpha_N & -\alpha_N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_N^i \\ b_N^r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \alpha_{N+1} \end{pmatrix} b_{N+1}^t$$
(45)

である.これも書き直して,

$$\begin{pmatrix} b_N^i \\ b_N^r \end{pmatrix} = \frac{1}{t_N} \begin{pmatrix} 1 \\ r_N \end{pmatrix} b_{N+1}^t$$
 (46)

となる.式(44)および(46)から,磁場の振幅強度の反射率, および,透過率は

$$\frac{b_1}{b_1^i} = \frac{m_{21} + m_{22}r_N}{m_{11} + m_{12}r_N} \tag{47}$$

$$\frac{b_{N+1}^{i}}{b_{1}^{i}} = \frac{t_{N}}{m_{11} + m_{12}r_{N}} \tag{48}$$

で与えられる.

. .

#### 3.2 多波干渉の分散関係

複数の境界面があって多波干渉する場合は,式(47)の特 異点,つまり,分母がゼロとなる条件

$$m_{11} + m_{12}r_N = 0 \tag{49}$$

が共鳴条件(表面プラズモン共鳴の分散関係)となる.こ の条件は、1つの境界面に対する共鳴条件(23)に比べてか なり複雑な式になる.各媒質の厚みと誘電率が与えられて いる場合は、式(49)における未知パラメータは $k_x \ge k_{zj}$ である.この2つのパラメータは、式(22)の関係にあるの で、この関係を用いて $k_{zj}$ を消してしまえば、結局、式(49) の未知パラメータは $k_x$ だけになる.解析的な解を求めるこ とは困難であるが、数値計算すれば容易に $k_x$ を求めること ができる.したがって、周波数 $\omega$ に対して式(49)から $k_x$ を求めれば、表面プラズモン共鳴の正確な分散関係が得ら れる.

単層膜のように2つの境界面を持つ場合は,

$$1 + r_1 r_2 e^{2i\delta_2} = 0 \tag{50}$$

が共鳴条件となる.この式を,式(41)を用いて書き直すと

$$(\alpha_1 + \alpha_2)(\alpha_2 + \alpha_3) + (\alpha_1 - \alpha_2)(\alpha_2 - \alpha_3)e^{2i\delta_2} = 0$$
(51)

となる.この式は、媒質2の厚みをゼロにすれば( $\delta_2 = 0$ ),  $a_1 + a_3 = 0$ となり、1つの境界面の共鳴条件に一致する. プリズムに金属膜をつけただけの単純なクレッチマン配置 では、この単層膜の共鳴条件(51)から分散関係を求めれば よい.

#### 3.3 クレッチマン配置の例

ここでは、表面プラズモン共鳴に最も広く用いられてい るクレッチマン配置を例にして、多波干渉の理論から得ら れた一般的な分散関係を考察する.単純なクレッチマン配 置では、プリズム上に金属薄膜を蒸着したものを用いるの で、光を入射する側からガラス、金属、大気という3つの 媒質が存在することになる.光は全反射条件を満たす角度 でプリズム側から入射し、この時にできるエバネッセント 波によって金属と大気の境界面上に表面プラズモンを励起 する(ガラスと金属の間にも境界面は存在するが、表面プ ラズモンが励起される条件は満たしていない).式(10)か らわかるように、表面波が存在できるためには2つの媒質 の誘電率の符号が逆になっていなければならない.一般 に、金属やプラズマのように自由電子を持つ物質の誘電率 は Drude の式

$$\frac{\varepsilon}{\varepsilon_0} = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega(\omega + i\gamma_0)} \tag{52}$$

で与えられる[9]. 但し, ωp および γ0 は, プラズマ周波数

および自由電子に対する平均散乱周波数を表す. この式から, プラズマ周波数以下の周波数領域では誘電率が負になることがわかる.例として, 金の場合の光学定数(屈折率 $n \ge W$ 収係数 $\kappa$ )を示した(**図7**)[11]. 誘電率の実数部は $n^2 - \kappa^2$ で与えられるので,図示した 500 nm から 1000 nm の波長領域では負の符号を持つことになる.

ここでは、BK7と呼ばれる光学ガラス(屈折率は1.51)に 厚さ45ミクロンの金薄膜をつけた場合の反射率の入射角依 存性を示す(図8). 光の波長はヘリウムネオンレーザー (632.8 nm)とチタンサファイアレーザー(800.0 nm)の場合 である.波長632.8 nmと800.0 nmでの屈折率、吸収係数は、 それぞれn=0.173、 $\kappa=3.422$ とn=0.165、 $\kappa=4.902$ として 計算した. 図の縦軸は、光強度の反射率であり、振幅強度 の反射率を表す式(47)の2乗を計算したものである.

全反射条件を満たす臨界角度は 41.5 度程度であり, いず れの波長の場合でもこの角度で変曲点を見ることができ る.全反射の臨界角度より大きい入射角でも反射率が1よ り小さくなっているのは金による吸収のためである.2つ の波長のいずれの場合も,明確な反射率の極小値を観測す ることができる(波長 632.8 nm の場合は 43.8 度,波長 800.0 nm の場合は 42.6 度のところ).この極小値は表面プラズモ ンの共鳴条件に一致している.このことを確認するため, 単層膜の式(51)から得られる分散関係とエバネッセント波 の分散関係(式(26))が一致する入射角(共鳴条件を満た



図8 厚さ45ミクロンの金薄膜をつけた場合の反射率の入射角依 存性.

す入射角)を計算した.横軸に波長をとり,縦軸にこの入 射角をとった図を示す(図9).図8において反射率が極小 値になる角度と図9に示した入射角が一致していることが わかる.共鳴条件を満たす場合,入射波のエネルギーは表 面プラズモンを励起するのに使われてしまって,反射波の エネルギーがほとんどなくなってしまったと理解すること ができる.ここでは,単層膜の式(51)を用いて表面プラズ モンの分散関係を計算したので,プリズムの影響,および, 金の膜厚が有限である影響を含めた値になっている.しか しながら,この共鳴条件を満たす入射角については,単層 膜の式(51)の代わりに1つの境界面だけを考えた式(24)を 用いて計算してもほとんど変わらない.

表面プラズモンは、境界面に局在する波であるから、z方向には指数関数的に減衰する(図10). このことは、前述した表面波の考察においても式(8)、(9)で明らかにした. z方向の減衰距離(光強度が1/eになる距離)は $1/2I(k_z)$ で定義される. 但し、I()は虚数部を取り出す関数である. 同様に、x方向の減衰距離は $1/2I(k_x)$ で定義される.

波数ベクトルと誘電率の関係を表す式(22)および1つの 境界面だけ考えた分散関係(24)を用いて,これらの減衰距 離を求めると

$$\frac{1}{2I(k_x)} = \frac{c}{2\omega} \left[ I\left(\sqrt{\frac{\hat{\varepsilon}_1 \hat{\varepsilon}_2}{\hat{\varepsilon}_1 + \hat{\varepsilon}_2}}\right) \right]^{-1}$$
(53)







図10 表面プラズモンの減衰距離.

$$\frac{1}{2I(k_{z2})} = \frac{c}{2\omega} \left[ I\left(\sqrt{\frac{\hat{\varepsilon}_2^2}{\hat{\varepsilon}_1 + \hat{\varepsilon}_2}}\right) \right]^{-1}$$
(55)

を得る.例として,金と真空の境界面における波長800 nm の場合の値を計算すると, x 方向の減衰距離は 42.7 µm, 金 側のz方向の減衰距離は12.7 nm,真空側のz方向の減衰距 離は306 nm となる. x 方向の減衰距離は表面プラズモンを 応用する上で重要な物理量である.特に、後述するような 表面プラズモンを用いたイメージング測定においては, 空 間分解能を決定する値である[12]. クレッチマン配置の場 合、これらの減衰距離を正確に求めるためには、1つの境 界面だけ考えた式(24)の代わりに単層膜の式(51)を用いて 計算する必要がある. 波長800 nmで金の膜厚が45 nmのク レッチマン配置の場合、単層膜の式(51)を用いて計算した x 方向の減衰距離は 17.6 µm となる. この値は式 (53) から 得られた値の半分以下である.このことは、この共鳴条件 を満たす入射角が単層膜の式(51)、および、1つの境界面 だけ考えた式(24)のいずれを用いても変わらなかったこと と大きく異なる.

## 4. 表面プラズモン共鳴の応用例

バイオセンサーに代表されるように、表面プラズモン共 鳴を用いた様々な測定法が実用化されている. これらのほ とんどがプリズムに金属薄膜を蒸着したクレッチマン配置 を用いている.この場合,金属膜の外側(プリズムと反対 側)の媒質の誘電率に対して共鳴条件が極めて敏感である ことを利用している. 例えば、金属膜の外側に局所的に誘 電率の異なる物質が付着した場合(あるいは、局所的に誘 電率が変化した場合),その部分だけ共鳴条件がずれるた め、反射率の変化が生じる.プリズム側から入射するプ ローブ光の面積が、その変化の生じた領域の面積より十分 大きければ、プローブ光の反射率の変化として2次元分布 を測定することができる.これが、表面プラズモン共鳴を 用いた2次元イメージング(SPR イメージングとも呼ばれ ている)の原理である (図11). SPR イメージングの時間分 解能はプローブ光のパルス幅で決まる.したがって、ピコ 秒,あるいは、フェムト秒の超短パルスレーザーを用いれ ば、極めて高い時間分解能を得ることが可能である[13]. また、空間分解能はプローブ光の光学系と表面プラズモン の伝搬方向(ここではx方向)の減衰距離で決まる[14]. 前述したように、この減衰距離は金属膜の厚みや金属膜の 外側にある物質の誘電率に強く依存する[12].

ここでは、プリズム上に金属薄膜をつけ、さらに、その 上に薄い半導体膜をつけた簡易なデバイスを用いて、高時 間分解かつ高空間分解で2次元イメージング測定する応用 例を考えてみる.フェムト秒の高時間分解能を得るため に、プローブ光としては100 fs 程度のパルス幅を持つチタ ンサファイアレーザー(中心波長800 nm,波長幅10 nm)を 用いる.この程度のパルス幅であれば、共鳴条件に対する パルス幅の影響は小さい.光や粒子ビームを励起源(ポン プ)として半導体に照射すると、半導体内の価電子は励起 されて伝導電子が生成される.光や粒子ビームの照射量が



図11 表面プラズモン共鳴を用いた2次元イメージング.

大きければ、多量の伝導電子が生成されるので、半導体の 光学定数も変化する.この光学定数の変化をプローブ光で 検出すればよい.この場合,励起源を照射するタイミング に対して、時間遅延をつけたプローブ光で計測すれば、ポ ンプ&プローブ実験として、光学定数の時間変化を測定す ることができる. 但し、プローブ光によって伝導電子が生 成されては困るので、プローブ光のフォトンエネルギー は、半導体のバンドギャップエネルギーに比べて小さい必 要がある. 波長 800 nm に相当するフォトンエネルギーは 1.55 eV なので,バンドギャップエネルギーとしては,2 eV 以上が適当である. 図12に、各種半導体のバンドギャップ エネルギーと屈折率の関係をまとめた. 半導体を光や粒子 測定のセンサーとして用いるためには、ある程度の厚みが 必要である.光を対象とする場合は光の侵入距離が,また, 粒子を対象とする場合は粒子の飛程(粒子が物質中でエネ ルギーを損失して止まるまでの平均距離)が半導体の厚み を決めるための目安となる、式(49)を用いて計算してみる と、半導体の屈折率が大きい程、また、半導体膜の厚みが 大きい程、共鳴条件を満たす入射角が大きくなることがわ かる.入射角が大きくなると、斜めから入射する影響とし



図12 各種半導体のバンドギャップエネルギーと屈折率.

て,観測する光学系の焦点のボケが大きくなる.したがっ て,半導体の屈折率としては,できるだけ小さいものが望 ましい.

ここでは、金属膜として金を用い、半導体膜として ZnSe (バンドギャップエネルギーは 2.6 eV,屈折率は 2.51[15]) を用いることにする.プリズム上に金薄膜だけをつけた場 合、その厚みを 45 nm にすれば表面プラズモン共鳴での反 射率がほぼゼロになる(図8).この場合の共鳴条件を満た す入射角は42.6度である.金薄膜の上にZnSe薄膜をつけた 場合の SPR 曲線(入射角に対する反射率の依存性)を示す (図13).ZnSe 膜の厚さを変えた場合、共鳴条件を満たす入 射角は大きく変化するが、いずれの厚さの場合でも反射率 はほぼゼロになっている.測定対象とする光や粒子(ポン プ&プローブ実験におけるポンプ)が入射した領域では、 半導体の光学定数が変化し、共鳴条件からずれることにな る.したがって、光学定数の変化に対応して反射率が大き くなり、反射率の変化量から光学定数の変化量を評価する ことができる.

どの程度の反射率変化が生じるかを確かめるため, ZnSeの屈折率を変えて反射率を計算してみた(図14).屈 折率の変化量として0.01程度は容易に検出することができ ると予測される.光や粒子を半導体に照射した場合,半導 体内の価電子が励起されて伝導電子が生成される.これに よる光学物性の変化は,屈折率だけでなく,吸収係数も変



図13 プリズム上に金(厚さ45 nm)とZnSe 膜(厚さ10-40 nm) を蒸着した場合の SPR 曲線.





化する.吸収係数のわずかな変化に対しても,SPR曲線が 大きく変化することがわかっており[16],測定で得られた SPR曲線から,屈折率と吸収係数の変化量を同時に評価す ることも可能である[17].前述したように,この測定の空 間分解能は観測する光学系だけでなく,表面プラズモンが 伝搬する方向の減衰距離で決まる.式(49)を用いて計算し てみると,プリズム上に金薄膜だけをつけた場合の減衰距 離17.6 μmに比べて,厚さ20 nmのZnSe薄膜をつけた場合 の減衰距離は4.9 μmとなり,かなり短くなることがわかっ た.したがって,金薄膜だけをつけた場合に比べて,空間 分解能を大幅に改善することができると考えられる.

近年,フェムト秒オーダーのパルス幅を持つ高強度レー ザーの発展にともなって,レーザー励起型の新しいX線源 や粒子源が注目されている.また,次世代の放射光源とし て,100 fs 以下のパルス幅を持つX線自由電子レーザーの 開発が進められている.これらは,従来にない超短パルス の量子ビームとして,新たな応用分野を開拓しつつある. ここで紹介した2次元イメージング測定法は,こうした超 短パルスの量子ビームに対する計測手法として様々な応用 が期待できる.

#### 5. まとめ

表面プラズモンについて,マックスウェル方程式を用い た表面波の考察から出発して、電磁気学的な観点からの基 礎を明らかにした. さらに、多波干渉理論を用いて複数の 境界面がある場合の表面プラズモンの一般的な共鳴条件 (分散関係)を求めた.表面プラズモンが存在できるのは, 磁場が横波である TM モードの場合だけであり、TM モー ドの電磁波を入射した場合、振幅反射率の特異点(分母が ゼロになる点)が表面プラズモンの共鳴条件を与える.表 面プラズモンが伝搬する方向の減衰距離の例からもわかる ように、実際の実験系に見られるような複数の境界面があ る場合は、多波干渉理論から得られた正確な分散関係が実 用的にも重要な知見を与える。物理的には、表面プラズモ ンとプラズマ表面波は同じものであり(両者の波の分散関 係は全く同一のものになる), ここでの拙い解説が, 表面プ ラズモンの応用分野だけでなく、プラズマ表面波の応用に おいても役立つことを期待したい.

#### 参考文献

- [1] 塚田 捷:表面の電子励起(丸善, 1996).
- [2] N.A. Krall and A.W. Trivelpiece, *Principles of Plasma Physics* (McGraw-Hill Inc., 1973).
- [3] H. Raether, Surface Plasmons on Smooth and Rough Surfaces and on Gratings (Springer-Verlag, 1988).
- [4] A. Otto, Z. Phys. 216, 398 (1968).
- [5] E. Kretschmann, Z. Phys. 241, 313 (1971).
- [6] 栗原一嘉, 鈴木孝治: ぶんせき 4,161 (2002).
- [7] 林真至:応用物理 71,705 (2002).
- [8] 永津雅章, 菅井秀郎:プラズマ・核融合学会誌 74,479 (1998).
- [9] 鶴田匡夫:応用光学Ⅰ, Ⅱ (培風館, 1990).
- [10] 宮本健郎:光学入門(岩波書店, 1995).

- [11] E.D. Palik, Handbook of Optical Constants of Solids (Academic Press Inc., 1985).
- [12] B. Rothenhausler and W. Knoll, J. Opt. Soc. Am. B 5, 1401 (1988).
- [13] A. Devizis, V. Vaicikauskas and V. Gulbinas, Appl. Opt. 45, 2535 (2006).
- [14] C.E.H. Berger, R.P.H. Kooyman and J. Greve, Rev. Sci. Instrum. 65, 2829 (1994).
- [15] 工藤恵栄:基礎物性図表(共立出版, 1972).
- [16] H. Kano and S. Kawata, Appl. Opt. 33, 5166 (1994).
- [17] K. Kurihara and K. Suzuki, Anal. Chem. 74, 696 (2002).

## 用語解説

## プラズモン

固体中での自由電荷(電子)の集団振動のことであり, フォノンなどと同様に量子力学的な準粒子と見なす場合の 呼び名である.但し,量子力学的な観点でなくてもプラズ モンという呼び名は一般的に使われている.バルクでのプ ラズモンは自由電荷の疎密波(縦波)であるが,表面では 境界条件を満足するために別の振動モードが存在する.こ の表面固有の振動モードを表面プラズモンという.

## ポラリトン

プラズモンやフォノンのような固体中での集団振動を素 励起と呼び,素励起が電磁波と結合した系をポラリトンと 呼ぶ.外部から与えた電磁波によってプラズモンを励起す る場合,自由電荷の振動にともなって電磁波の振動が誘起 される.この電磁波の振動は,電荷の振動に影響するため, 両者の振動が結合したプラズモンポラリトンをつくること になる.表面プラズモンが電磁波と結合した系は表面プラ ズモンポラリトンと呼ばれる.

#### 表面プラズモン共鳴

電磁波で表面プラズモンを励起するためには,電磁波の 位相速度が表面プラズモンの位相速度に一致しなければな らない.しかし,通常の媒質を伝搬する電磁波を物質表面 に入射しても,両者の位相速度が一致するような条件は得 られない.電磁波が境界面で全反射する時に発生するエバ ネッセント波を用いると,その位相速度を表面プラズモン の位相速度に一致させることができる.この場合,表面プ ラズモンを共鳴的に励起することができるため,表面プラ ズモン共鳴(SPR)と呼ばれている.



#### SPR 曲線

境界面へ電磁波を入射して全反射させた時に発生するエ バネッセント波を用いて表面プラズモンを励起する場合, ある入射角の時だけエバネッセント波の位相速度と表面プ ラズモンの位相速度が一致する(共鳴条件).この共鳴条件 は,入射した電磁波の反射率が極小値になる角度として観 測することができる.こうした反射率の入射角依存性は, 表面プラズモン特性を最も良く表すものであり,SPR 曲線 と呼ばれる.

#### エバネッセント波

屈折率の異なる2つの媒質の境界面に対して,屈折率の 大きな媒質側から臨界角以上の入射角で電磁波を入射した 場合に全反射が起きる(媒質による吸収がなければ,反射 率は1になる).全反射した場合,境界面近傍で屈折率の小 さな媒質側にしみ出した電磁場が発生する.この電磁場 は,境界面に沿って伝搬する波であるが,境界面に垂直な 方向には急激に減衰するため,エバネッセント波と呼ばれ ている.

#### 多波干涉

1つの境界面に電磁波を入射した場合,入射した波は反 射波と透過波(屈折波)に分かれる.複数の境界面が存在 する場合は,ある境界面に対して,その前後の境界面から 来る反射波や透過波が存在するため,それらすべての波の 干渉を考慮する必要がある.こうした考え方を多波干渉と 呼ぶ.